

0978-1

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 2月27日

出願番号 Application Number: 特願2003-051571

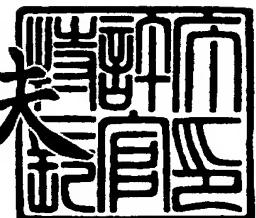
[ST. 10/C]: [JP2003-051571]

出願人 Applicant(s): ローム株式会社

2003年 9月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 PR2-00286
【提出日】 平成15年 2月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/331
【発明者】
【住所又は居所】 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内
【氏名】 高石 昌
【特許出願人】
【識別番号】 000116024
【住所又は居所】 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
【氏名又は名称】 ローム株式会社
【代理人】
【識別番号】 100087701
【弁理士】
【氏名又は名称】 稲岡 耕作
【選任した代理人】
【識別番号】 100101328
【弁理士】
【氏名又は名称】 川崎 実夫
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 011028
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9401527
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体基板上に形成されたコンタクトホールを埋めるようにアルミニウムを含む薄膜を形成する半導体装置の製造方法であって、

上記半導体基板の表面において、上記コンタクトホールの内表面を含む所定面積を有する領域にシリコンを含む薄膜を形成する工程と、

この所定面積を有する領域にシリコンを含む薄膜を形成する工程の後、上記半導体基板の表面に、アルミニウムを含む薄膜を形成するアルミニウム薄膜形成工程と、

このアルミニウムを含む薄膜が形成された半導体基板を、アルミニウムに対するシリコンの拡散が生じる温度に加熱する加熱工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

上記所定面積を有する領域に上記シリコンを含む薄膜を形成する工程が、上記所定面積より広い領域に上記シリコンを含む薄膜を形成する工程と、

このシリコンを含む薄膜の面積が上記所定面積になるように、このシリコンを含む薄膜を除去する除去工程とを含むことを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

上記所定面積が、上記アルミニウム薄膜形成工程で形成されるアルミニウムを含む薄膜の面積の 99% 以下であることを特徴とする請求項 1 または 2 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

上記半導体基板は、上記コンタクトホールを含む複数のセルを備えたものであり、

上記アルミニウム薄膜形成工程で上記半導体基板の単位セルあたりに供給されるアルミニウム量に対する上記所定面積を有する領域に形成される単位セルあた

りの上記シリコンを含む薄膜に含まれているシリコン量の比が、原子比で0.1%以上かつ2%以下であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】

上記加熱工程が、上記半導体基板を380℃ないし570℃に加熱する工程を含むことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、MOSFETなどの半導体装置の製造方法に関し、特に、シリコン基板等の半導体基板上に形成された微細なコンタクトホールを埋め込むようにアルミニウムを含む薄膜を形成する工程を含む半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体装置の製造工程では、シリコン基板上に形成された微細なホール（穴）状またはトレンチ（溝）状のコンタクトホールを埋めるようにアルミニウムからなる電極薄膜が形成される。このような電極薄膜は、シリコン基板上に形成された素子（たとえば、トランジスタ）の取り出し電極をなす。

このような薄膜は、従来、スパッタ法により、シリコン基板上にアルミニウム原子を供給して、コンタクトホールを埋めるようにアルミニウム薄膜を形成することにより形成されていた。アルミニウム薄膜を形成する工程において、コンタクトホールがアルミニウム薄膜で埋められやすいように、シリコン基板が加熱されることもあった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、近年の配線パターンの微細化に伴い、コンタクトホールの幅や径が小さく（たとえば、0.6μm以下に）なってきている。一方、コンタクトホールの深さは配線パターンが微細化されてもほとんど変わらないので、コンタクト

ホールの幅または径に対するコンタクトホールの深さの比（アスペクト比）が、大きく（たとえば、1以上に）なる。

【0004】

このような幅や径が小さくアスペクト比が大きいコンタクトホールには、上述の方法では、コンタクトホールを良好に埋めるアルミニウム薄膜を形成することができなかった。具体的には、アルミニウム薄膜内でコンタクトホールに対応する部分にボイド（空隙）が形成されるという問題があった。これは、スパッタ法では、幅や径が小さくアスペクト比が大きいコンタクトホールの内部空間が、アルミニウム原子で完全に埋められる前に、コンタクトホールの開口を塞ぐようにアルミニウム薄膜が成長してしまうことによる。

【0005】

また、成膜時またはその後の工程で、アルミニウム薄膜から、シリコン基板上の拡散領域などへとアルミニウム原子が拡散（アルミスパイク）し、素子のp n接合が破壊されるという問題もあった。

そこで、この発明の目的は、半導体基板上に形成された幅や径が小さくアスペクト比が大きいコンタクトホールに、アルミニウムを含む薄膜を良好に埋め込むことができる半導体装置の製造方法を提供することである。

【0006】

この発明の他の目的は、コンタクトホールに埋め込まれたアルミニウムを含む薄膜から、アルミニウム原子が拡散しにくい半導体装置の製造方法を提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段および発明の効果】

上記の課題を解決するための請求項1記載の発明は、半導体基板（1）上に形成されたコンタクトホール（4）を埋めるようにアルミニウムを含む薄膜（11）を形成する半導体装置の製造方法であって、上記半導体基板の表面において、上記コンタクトホールの内表面を含む所定面積を有する領域にシリコンを含む薄膜（15）を形成する工程と、この所定面積を有する領域にシリコンを含む薄膜を形成する工程の後、上記半導体基板の表面に、アルミニウムを含む薄膜（11）

, 16) を形成するアルミニウム薄膜形成工程と、このアルミニウムを含む薄膜が形成された半導体基板を、アルミニウムに対するシリコンの拡散が生じる温度に加熱する加熱工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法である。

【0008】

なお、括弧内の英数字は後述の実施形態における対応構成要素等を示す。以下、この項において同じ。

この発明によれば、アルミニウムを含む薄膜（以下、「アルミニウム薄膜」という。）の形成に先立って、コンタクトホールの内表面を含む領域にシリコンを含む薄膜が形成される。シリコンを含む薄膜がコンタクトホールを埋めて形成される場合、その後実施されるアルミニウム薄膜形成工程で、たとえば、物理蒸着法により半導体基板上に供給されるアルミニウム原子は、コンタクトホール内を埋めて存在するシリコンを含む薄膜上にも供給される。また、シリコンを含む薄膜がコンタクトホールを埋めずに形成される場合、その後実施されるアルミニウム薄膜形成工程で、アルミニウム原子はコンタクトホールの内部（特に、内壁）には到達しにくい。

【0009】

いずれの場合でも、加熱工程で、コンタクトホール内のシリコンを含む薄膜を構成するシリコン原子はアルミニウム薄膜中に拡散するとともに、アルミニウム薄膜を構成するアルミニウム原子は、コンタクトホール内のシリコンを含む薄膜中に拡散しながらコンタクトホール内へと移動することができる。

これにより、コンタクトホール内はアルミニウム薄膜で良好に埋められる。特に、コンタクトホールの幅や径が $0.6 \mu\text{m}$ 以下と小さく、コンタクトホールのアスペクト比が1以上と高い場合、このような製造方法は効果がある。アルミニウム薄膜の不要な部分は、その後、エッチングなどにより除去してもよい。このようにして、コンタクトホールに良好に埋め込まれたアルミニウム薄膜を形成できる。

【0010】

コンタクトホールは、半導体基板の表層部に形成された素子に取り出し電極を接続するためのものであってもよく、多層配線の層間接続をするためのものであ

ってもよい。上記の方法により、たとえば、コンタクトホール内面に露出している半導体層（半導体基板自身であってもよい。）や配線とアルミニウム薄膜とを電気的に接続できる。

加熱工程は、アルミニウム薄膜形成工程と同時に実施されてもよく、アルミニウム薄膜形成工程終了後に実施されてもよい。また、加熱工程は、アルミニウム薄膜形成工程と同時に実施し、さらに、アルミニウム薄膜形成工程終了後、一定時間加熱を継続するものであってもよい。

【0011】

また、アルミニウム薄膜はシリコンを含んだものとなるため、コンタクトホールに埋め込まれたアルミニウム薄膜中のアルミニウム原子は、コンタクトホール内面に露出している半導体層（特に、シリコンからなるもの）へ拡散しにくくなる。これにより、当該半導体層の内方に形成されたp-n接合の破壊を防ぐことができる。

以上のような効果を奏するために必要なシリコンを含む薄膜中のシリコン量は少なく、たとえば、アルミニウムを含む薄膜中のアルミニウム量に対して、原子比で数%以下である。このため、シリコンを含む薄膜を形成するために半導体基板の表面全面にシリコンを供給すると、単位面積あたりに供給されるシリコン量が少なくなるので、シリコンの量を正確に制御することは困難である。

【0012】

この発明によれば、所定面積を有する領域が充分小さな面積を有するようにすることにより、この所定面積を有する領域に供給されるシリコン量を多くすることができます。したがって、シリコンを含む薄膜中のシリコン量を正確に制御することができる。

上記所定面積を有する領域の面積は、たとえば、上記アルミニウム薄膜形成工程で形成されるアルミニウムを含む薄膜の面積より小さいものとすることができる。半導体基板は、たとえば、シリコン基板であってもよく、表面にエピタキシャル層が形成されたものであってもよい。

【0013】

シリコンを含む薄膜を形成する工程は、化学蒸着法によりポリシリコンの薄膜

を形成する工程を含んでいてもよい。化学蒸着法により、コンタクトホールの内部にポリシリコン膜を良好に形成できる。アルミニウム薄膜形成工程は、たとえば、物理蒸着法の一例であるスパッタ法によりアルミニウム薄膜を形成する工程を含んでいてもよい。

請求項2記載の発明は、上記所定面積を有する領域に上記シリコンを含む薄膜を形成する工程が、上記所定面積より広い領域に上記シリコンを含む薄膜を形成する工程と、このシリコンを含む薄膜の面積が上記所定面積になるように、このシリコンを含む薄膜を除去する除去工程とを含むことを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法である。

【0014】

この発明によれば、たとえば、所定のパターンを有するマスクを用いた除去工程により、シリコンを含む薄膜の面積を正確に所定の面積にすることができる。

所定面積を有する領域より広い領域に上記シリコンを含む薄膜を形成する工程は、半導体基板においてコンタクトホールが形成された面の全面にシリコンを含む薄膜を形成するものであってもよい。除去工程は、エッチングにより、上記シリコンを含む薄膜を除去する工程を含んでいてもよい。

【0015】

請求項3記載の発明は、上記所定面積が、上記アルミニウム薄膜形成工程で形成されるアルミニウムを含む薄膜の面積の99%以下であることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の半導体装置の製造方法である。

シリコンを含む薄膜が形成される所定面積と、アルミニウム薄膜の面積との割合を、上記のようにすることにより、アルミニウム薄膜中のアルミニウム量に対するシリコン量の精度を高くすることができる。アルミニウム薄膜の面積に対する上記所定面積の割合が小さいほど、アルミニウム薄膜中のアルミニウム量に対するシリコン量の精度を高くすることができる。

【0016】

請求項4記載の発明は、上記半導体基板は、上記コンタクトホールを含む複数のセル(C)を備えたものであり、上記アルミニウム薄膜形成工程で上記半導体基板の単位セルあたりに供給されるアルミニウム量に対する上記所定面積を有す

る領域に形成される単位セルあたりの上記シリコンを含む薄膜に含まれているシリコン量の比が、原子比で0.1%以上かつ2%以下であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の半導体装置の製造方法である。

【0017】

これにより、上述の拡散によるアルミニウム原子の移動が有効に生じて、コンタクトホールに良好にアルミニウム薄膜を埋め込むことができる。また、過剰なシリコンによるシリコンノジュールの発生を防ぐこともできる。シリコンを含む薄膜に含まれるシリコン量は、アルミニウムに対する量が除去工程後に上記の割合になっていればよく、シリコンを含む薄膜が形成された直後には、アルミニウム量に対して、より多くてもよい。

【0018】

このようにアルミニウム薄膜中のアルミニウム量に対するシリコンを含む薄膜中のシリコン量が小さい場合でも、上述のように所定面積を有する領域に供給されるシリコン量を多くできるので、シリコン量を正確に制御できる。

請求項5記載の発明は、上記加熱工程が、上記半導体基板を380℃ないし570℃に加熱する工程を含むことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の半導体装置の製造方法である。

【0019】

加熱工程において、半導体基板を380℃以上に加熱することにより、上述のアルミニウム原子およびシリコン原子の拡散を好適に生じさせ、コンタクトホールに良好にアルミニウム薄膜を埋め込むことができる。

また、半導体基板の加熱温度を570℃以下とすることにより、コンタクトホールに埋め込まれたアルミニウム薄膜から、半導体基板などへのアルミニウム原子の拡散を少なくできる。

【0020】

【発明の実施の形態】

以下では、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

図1は、本発明の製造方法を適用して製造されるMOSFET(Metal Oxide

Semiconductor Field Effect Transistor)の構造を示す図解的な断面図である。

【0021】

シリコン基板1の表層部には、n-型のエピタキシャル層2が形成されている。エピタキシャル層2の上には、複数のリッジ形状の積層膜3が形成されている。積層膜3は、シリコン基板1の表面に沿う第1の方向(図1で、紙面に垂直な方向)に延びるものと、シリコン基板1の表面に沿い第1の方向に直交する第2の方向(図1で、紙面に平行な方向)に延びるものとを含んでいる。それぞれの方向に関して、複数の積層膜3が互いにほぼ平行に配列されている。すなわち、積層膜3は格子状に形成されている。積層膜3で囲まれた領域は、コンタクトホール(穴)4となっている。コンタクトホール4はエピタキシャル層2に達しない深さを有している。

【0022】

積層膜3は、下部(エピタキシャル層2側)から上部に向かって積層された、p-層5、n⁺層6、および酸化シリコン層7を含んでいる。

各積層膜3の内部には、エピタキシャル層2の上部から積層膜3の積層方向に延びるポリシリコン層8が形成されている。ポリシリコン層8は、p-層5およびn⁺層6を貫通しており、上部(エピタキシャル層2側とは反対側)で酸化シリコン層7に接している。ポリシリコン層8は、不純物の添加により導電化されていて、シリコン基板1の端部で外部接続されており、FETのゲート電極として機能するようになっている。

【0023】

ポリシリコン層8の周囲には、酸化シリコン層7と接する部分を除いて、酸化膜(ゲート酸化膜)9が形成されている。

コンタクトホール4の底部で、隣接する積層膜3のp-層5間、およびエピタキシャル層2に接する部分には、p-層5より層厚が薄いp⁺層10が形成されている。積層膜3およびp⁺層10の上部には、コンタクトホール4を埋めるようにアルミニウム(A1)を主成分とするアルミニウム電極膜11が形成されている。アルミニウム電極膜11は、少量(たとえば、原子比でアルミニウムに対し

て0.3%)のシリコンを含んでいる。アルミニウム電極膜11は、n⁺層6の取り出し電極として機能するようになっている。

【0024】

アルミニウム電極膜11とシリコン基板1に接続された図示しない電極との間に一定の大きさの電圧を印加するとともに、ポリシリコン層8(ゲート電極)を所定の電位にすることにより、p⁻層5を通して、n⁺層6とエピタキシャル層2との間に電流(ドレイン電流)を流すことができる。ドレイン電流は、p⁻層5中で酸化膜9近傍を、酸化膜9に沿って流れる。すなわち、p⁻層5中で酸化膜9近傍の部分にチャネルが形成される。

【0025】

以上のような構造のMOSFETにおいて、コンタクトホール4の幅W1は、たとえば、0.6μmであり、コンタクトホール4の幅W1に対する深さDの比(アスペクト比)D/W1は大きい(たとえば、1以上)。ポリシリコン層8の幅W2は、たとえば、0.6μmであり、積層膜3のうちポリシリコン層8の片側に存在する部分の幅W3は、たとえば、0.45μmである。したがって、このMOSFETの素子単位(セルC)の幅W4は、たとえば、2.1μmである。チャネルが縦方向に(シリコン基板1に垂直な方向)に形成されていることに加え、n⁺層6とアルミニウム電極膜11とが、コンタクトホール4の内側壁で接触されることにより、このような小さなセルCが実現されている。

【0026】

このように、セルCを小さくすることにより、単位面積あたりに多くのセルCを形成することができる。これにより、単位面積あたりのチャネルの数およびエピタキシャル層2において電流が流れる領域を多くすることができる。したがって、オン抵抗を低減することができる。

図2は、アルミニウム電極膜11の形成工程を説明するための図解的な断面図である。

【0027】

先ず、p⁺層10および積層膜3上に、CVD(化学蒸着)法により、シリコン基板1のほぼ全面に渡ってポリシリコン膜15が形成される(図2(a)参照)

）。ポリシリコン膜15は、積層膜3の側面（コンタクトホール4の内壁）および上面、p⁺層10の上面などに均一な厚さで形成される。ポリシリコン膜15の厚さは、たとえば、1000Åとすることができる。

次に、ポリシリコン膜15の表面に所定のパターンの開口を有するマスクが形成される。マスクはコンタクトホール4およびその周辺を覆うように形成され、マスクの開口からは酸化シリコン層7の頂部に対応する領域が露出される。そして、このマスクの開口を介したエッチングによりポリシリコン膜15が除去される。これにより、ポリシリコン膜15は、コンタクトホール4の内面を含む領域にのみ、所定の面積を有して存在するようになる。この状態が、図2（b）に示されている。

【0028】

図3は、エッチング後のポリシリコン膜15の分布を示す図解的な斜視図である。ポリシリコン膜15は、平面視においてほぼ正方形の所定面積を有する領域が残るようにされる。酸化シリコン層7の一部は、ポリシリコン膜15から露出される。

図2を参照して、このようにして所定面積を有する領域にポリシリコン膜15が形成されたシリコン基板1のほぼ全面に、スパッタ法により、アルミニウム原子が堆積されてアルミニウム薄膜16が形成される。この際、シリコン基板1は加熱される。加熱温度は、380℃ないし570℃とされる。

【0029】

スパッタ法によりシリコン基板1上に供給されたアルミニウム原子は、コンタクトホール4の内部には到達しにくいので、成膜の初期には、アルミニウム原子は主にコンタクトホール4の外部に堆積してアルミニウム薄膜16を形成する。アルミニウム原子は、上記の温度範囲ではポリシリコン膜15中に拡散するので、コンタクトホール4外に形成されたアルミニウム薄膜16の一部は、コンタクトホール4内に流れ込むように移動する。

【0030】

また、ポリシリコン膜15を構成するシリコン原子も、アルミニウム薄膜16中へと拡散する。このようして、コンタクトホール4は次第にアルミニウム薄膜

16で埋められていき（図2（c）参照）、成膜終了時にはコンタクトホール4は、アルミニウム薄膜16により完全に埋められる。シリコン基板1へのアルミニウム原子の供給を停止した後、適当な時間シリコン基板1の加熱を継続することとしてもよい。

【0031】

このようにして、図1に示すように、ボイド（空隙）のない良好なアルミニウム電極膜11が得られる。特に、コンタクトホール4が、幅や径が0.6μm以下と小さく、アスペクト比が1以上と高い場合、このような製造方法は効果がある。

ポリシリコン膜15をエッチングにより除去した後の単位セルCあたりのポリシリコン膜15（図2（b）および図3参照）に含まれるシリコン量は、スパッタ法によりシリコン基板1に供給される単位セルCあたりのアルミニウム量に対して、原子比で0.1%以上かつ2%以下とされる。これにより、上述の拡散によるアルミニウム原子の移動が有効に生じて、コンタクトホール4に良好にアルミニウム電極膜11を埋め込むことができる。また、過剰なシリコンによるシリコンノジュールの発生を防ぐこともできる。

【0032】

このため、アルミニウム電極膜11は、アルミニウムを主成分とし、少量（たとえば、原子比でアルミニウムに対して0.3%）のシリコンを含んだものとなる。

また、シリコン基板1に供給するアルミニウム量に対するエッチング後のシリコン量の比は、シリコン基板1を加熱する工程の温度におけるアルミニウムに対するシリコンの固溶限界内とすることが好ましい。この場合、ポリシリコン膜15を構成するシリコン原子は全量アルミニウム薄膜16中へと移動し、アルミニウム薄膜16の成膜終了後には、アルミニウム薄膜16（アルミニウム電極膜11）とp⁺層10および積層膜3との間には、ポリシリコン膜15は存在しなくなる。

【0033】

アルミニウム電極膜11が形成された後、アルミニウム電極膜11の不要部分

は、エッチングなどにより除去される。

アルミニウム電極膜11が固溶限界内のシリコンを含んでいることにより、スパッタ法によるアルミニウム電極膜11形成時や他の工程において、シリコン基板1が加熱されて高温になった場合でも、アルミニウム電極膜11を構成するアルミニウム原子は、p⁺層10、積層膜3、エピタキシャル層2などへ拡散しにくい。したがって、素子を構成するエピタキシャル層2、p⁻層5、およびn⁺層6にアルミニウム原子が拡散して、p-n接合が破壊されることはない。

【0034】

このようにしてアルミニウム電極膜11を形成する場合、アルミニウム電極膜11を形成する前にバリアメタル層を形成する必要もない。

以上の半導体装置の製造方法において、エッチング後のポリシリコン膜15の面積は、アルミニウム薄膜16の面積（アルミニウム原子が供給される面積）のたとえば10%程度とされる。このため、ポリシリコン膜15がシリコン基板1のほぼ全面に渡って形成されていた場合と比べて、ポリシリコン膜15を10倍程度の厚さで形成することができる。

【0035】

すなわち、ポリシリコン膜15がシリコン基板1のほぼ全面に渡って形成されていた場合は、ポリシリコン膜15は100Å程度の厚さとなる。このように薄いポリシリコン膜15を形成しようとすると、単位面積あたりに供給されるシリコン量が少なくなり、シリコン量の精度が悪くなる。一方、エッチング後のポリシリコン膜15の面積を上述のように小さくすることにより、単位面積あたりに供給するシリコン量を多くでき、シリコン量の精度を高くできる。

【0036】

上記所定面積を有する領域に形成されるポリシリコン膜15の面積は、たとえば、アルミニウム薄膜16の面積の99%以下とすることができます。これにより、アルミニウム薄膜16中のアルミニウム量に対するポリシリコン膜15中のシリコン量の精度を高くすることができる。

この発明の一実施形態の説明は、以上の通りであるが、この発明は他の形態でも実施することもできる。たとえば、本発明に係る製造方法は、MOSFET

以外の半導体装置の様々なコンタクトホールを埋めて薄膜を形成する場合にも適用可能である。

【0037】

たとえば、上記の実施形態では、アルミニウム電極膜11はコンタクトホール4側面に露出したp⁺層6（半導体層）に電気的に接続されるように形成されているが、コンタクトホール底面に露出している半導体層（基板自身を含む。）に電気的に接続されるように形成されてもよい。この場合、コンタクトホールの内側壁には絶縁体のみが露出していてもよい。

さらに、コンタクトホール4は、半導体層（素子）に取り出し電極を接続するためのものに限らず、配線（たとえば、金属からなる配線）の層間接続を行うためのものであってもよい。この場合、コンタクトホール4内（たとえば、コンタクトホール4の底面）に配線が露出するようにし、上記の実施形態と同様の方法により、このコンタクトホール4内にアルミニウム電極膜11を埋め込むものとすることができる。

【0038】

また、アルミニウム電極膜11は、コンタクトホール内に露出している導体に電気的に接続されるものであってもよい。

薄膜（電極配線）を埋め込むコンタクトホールは、幅または径が0.6μm以下のものに限らず、幅または径が0.6μmより大きいものであってもよい。また、薄膜（電極配線）を埋め込むコンタクトホールは、アスペクト比が1以上のものに限らず、アスペクト比が1未満のものであってもよい。

【0039】

半導体装置は、MOSFET以外に、たとえばIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)などの半導体装置であってもよい。

シリコン基板1を加熱する工程は、シリコン基板1上にアルミニウム原子を堆積させる工程（図2（c）参照）の終了後別途実施されてもよい。

その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の変更を施すことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の製造方法を適用して製造されるMOSFETの構造を示す図解的な断面図である。

【図2】

アルミニウム電極膜の形成方法を説明するための図解的な断面図である。

【図3】

エッチング後のポリシリコン膜の分布を示す図解的な斜視図である。

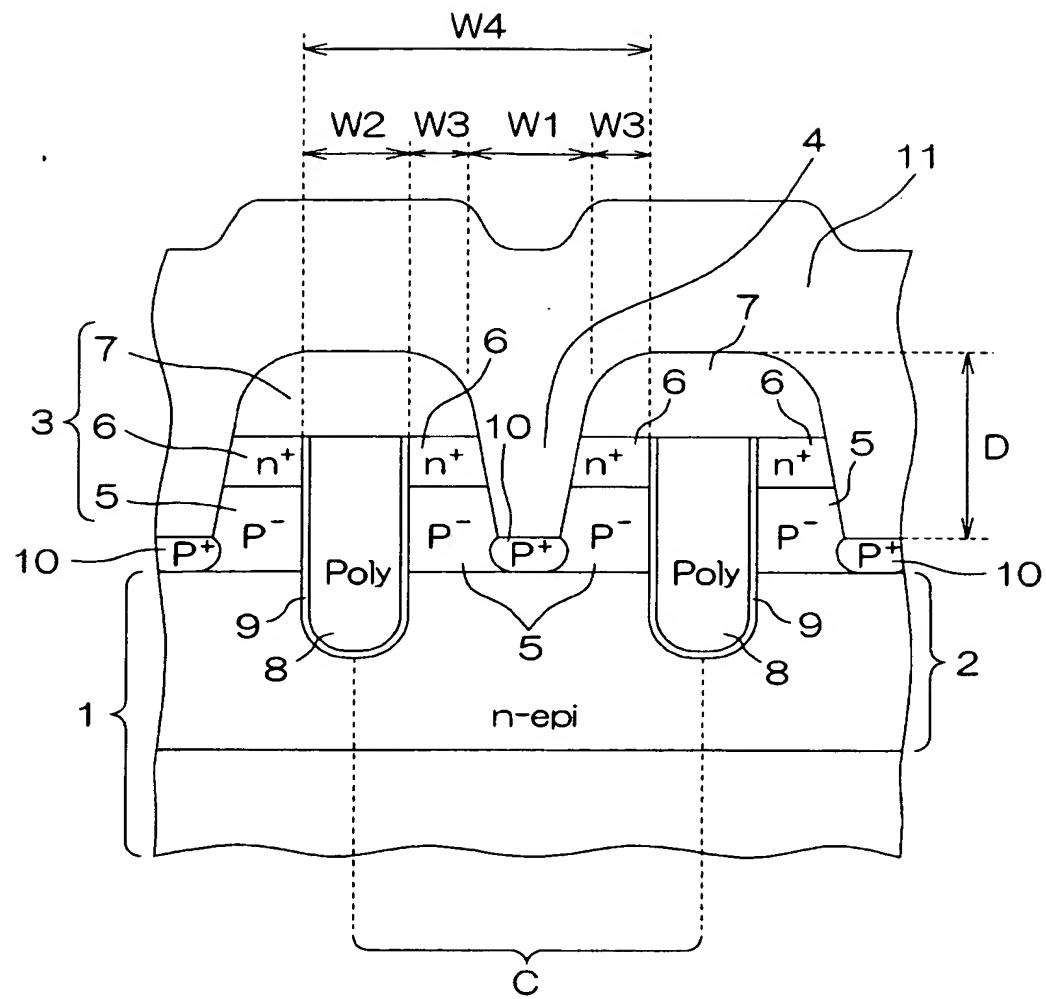
【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 4 コンタクトホール
- 11 アルミニウム電極膜
- 15 ポリシリコン膜
- 16 アルミニウム薄膜
- C セル

【書類名】

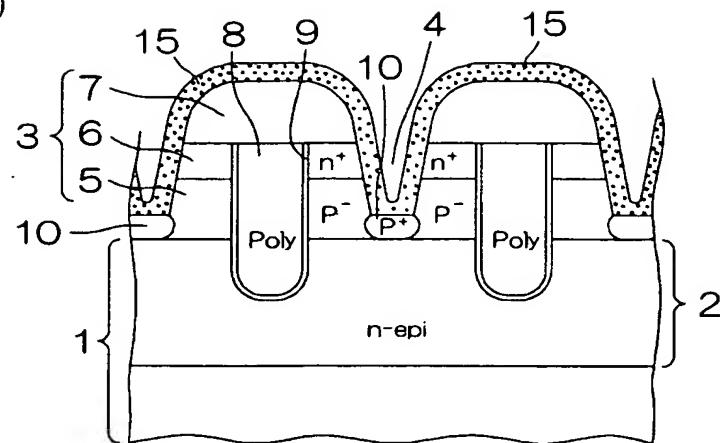
四面

【図 1】

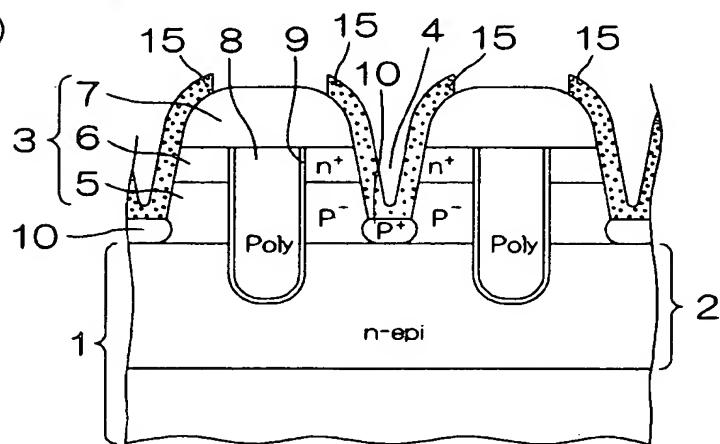


【図2】

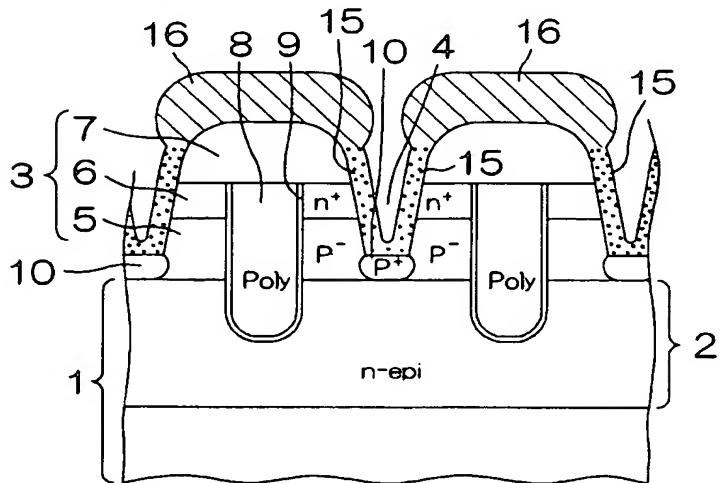
(a)



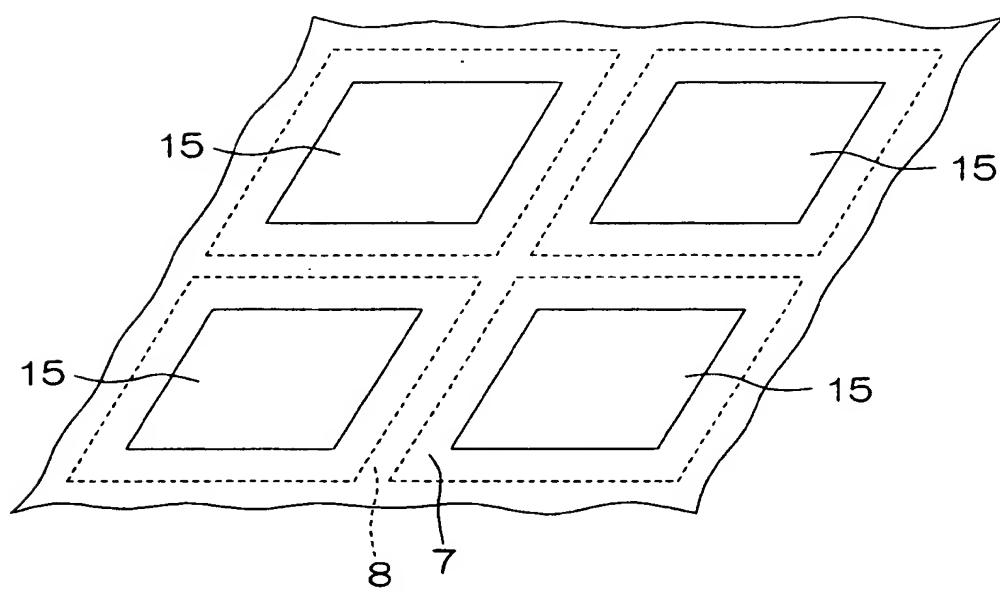
(b)



(c)



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体基板上に形成された幅や径が小さくアスペクト比が大きいコンタクトホールに、アルミニウムを含む薄膜を良好に埋め込むことができる半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 表面にコンタクトホール4が形成されたシリコン基板1上に、ほぼ全面に渡って、化学蒸着法により、ポリシリコン膜15が形成される（図2（a））。次に、所定のパターンの開口を有するマスクを介したエッチングによりポリシリコン膜15が除去されて、ポリシリコン膜15がコンタクトホール4の内面を含む所定面積を有する領域にのみ存在する状態にされる（図2（b））。その後、シリコン基板1のほぼ全面に、スパッタ法により、アルミニウム原子が堆積されてアルミニウム薄膜16が形成される（図2（c））。この際、シリコン基板1が加熱される。

【選択図】 図2

特願 2003-051571

出願人履歴情報

識別番号 [000116024]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
氏 名 ローム株式会社